

20

السؤال الأول © 20 درجة (2 درجة لكل سؤال)

اختر الخيار الصحيح على الأسئلة التالية (خيار واحد صحيح):

<p>6- عندما يعمل MOSFET في منطقة التريود فإن <math>C_{gs}</math> تساوي:</p> <p>(a) <math>C_{gs} = \frac{2}{3} WLC_{ox}</math></p> <p>(b) <math>C_{gs} = 0</math></p> <p>(c) <math>C_{gs} = \frac{1}{2} WLC_{ox}</math> (2)</p> <p>(d) <math>C_{gs} = WLC_{ox}</math></p>	<p>1- في دارة MOSFET عندما <math>V_{GS} = 0</math> فإن قيمة المقاومة <math>r_{DS}</math> تساوي تقريباً:</p> <p>(a) <math>10^{12} k\Omega</math></p> <p>(b) <math>10^6 M\Omega</math> (2)</p> <p>(c) <math>10^9 \Omega</math></p> <p>(d) <math>10^6 k\Omega</math></p>
<p>7- تنخفض الاستجابة المطالية للمكبر عند الترددات العالية بسبب:</p> <p>(a) مكثفات الربط coupling capacitors.</p> <p>(b) مكثفات التجاوز by-pass capacitors.</p> <p>(c) مكثفات الربط والتجاوز.</p> <p>(d) السعات الداخلية للترانزستور. (2)</p>	<p>2- في دارة MOSFET فإنه بزيادة الجهد <math>V_{GS}</math>:</p> <p>(a) يتناقص <math>I_D</math>.</p> <p>(b) تزداد المقاومة <math>r_{DS}</math>.</p> <p>(c) يتناقص عرض القناة.</p> <p>(d) جميع الخيارات السابقة خاطئة. (2)</p>
<p>8- يعتبر تحيز MOS عن طريق تثبيت قيمة <math>V_{GS}</math> فقط:</p> <p>(a) طريقة جيدة للحصول على <math>I_D</math> ثابت.</p> <p>(b) طريقة غير جيدة بسبب أنها تؤدي لـ <math>I_D</math> ثابت.</p> <p>(c) طريقة جيدة بسبب أن <math>I_D</math> لا يعتمد على <math>V_T</math>.</p> <p>(d) جميع الخيارات السابقة خاطئة. (2)</p>	<p>3- في دارة MOSFET العملي فإنه بزيادة الجهد <math>v_{DS}</math>:</p> <p>(a) تنقلص منطقة النضوب.</p> <p>(b) يزداد طول القناة.</p> <p>(c) يتناقص طول القناة. (2)</p> <p>(d) جميع الخيارات السابقة خاطئة.</p>
<p>9- يحدث تأثير إيرلي في الترانزستور BJT بسبب:</p> <p>(a) تناقص طول القناة L.</p> <p>(b) زيادة تيار <math>I_c</math> عند زيادة <math>v_{CE}</math> في منطقة الاشباع.</p> <p>(c) تزايد طول القناة L.</p> <p>(d) جميع الخيارات السابقة خاطئة. (2)</p>	<p>4- يؤدي توصيل مقاومة <math>R_s</math> لرجل منبع MOSFET لـ:</p> <p>(a) تخفيض عرض المجال الترددي للمكبر.</p> <p>(b) زيادة ربح المكبر.</p> <p>(c) زيادة مطال الإشارة على دخل الترانزستور.</p> <p>(d) تقليل التشويه اللاخطي. (2)</p>
<p>10- تحدث القيمة العظمى لربح الجهد في دارة مكبر BJT:</p> <p>(a) عند القيمة <math>V_{BE} = 0.5 V</math></p> <p>(b) عند القيمة <math>V_{CE} = 0.1 V</math> (2)</p> <p>(c) عند القيمة <math>V_{CE} = 0.3 V</math></p> <p>(d) عند القيمة <math>V_{BE} = 0.7 V</math></p> <p><math>A_v = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{V_T}</math></p>	<p>5- يستخدم ترتيب CD (مصرف مشترك) لوصل:</p> <p>(a) منبع عالي المقاومة إلى حمل عالي المقاومة.</p> <p>(b) منبع عالي المقاومة إلى حمل منخفض المقاومة. (2)</p> <p>(c) منبع منخفض المقاومة إلى حمل منخفض المقاومة.</p> <p>(d) منبع منخفض المقاومة إلى حمل عالي المقاومة.</p>

15

السؤال الثاني © 15 درجة (9+6)

لتكن لدينا دارة المكبر المبينة في الشكل التالي:

حيث:  $\lambda = 0$ ,  $W/L = 10$ ,  $k'_n = 0.4 mA/V^2$ ,  $V_t = 0.1 V$

$V_{GS} = 0.6 V$ ,  $R_D = 17.5 k\Omega$ ,  $V_{DD} = 1.8 V$

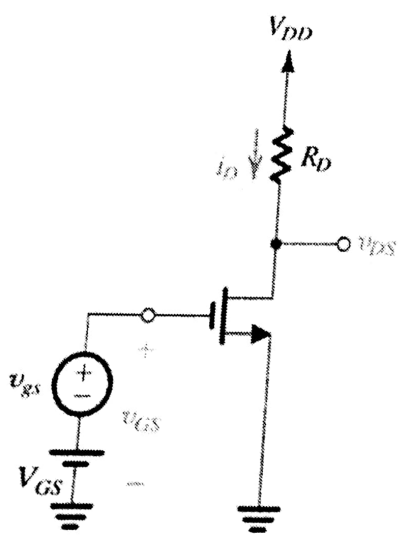
والمطلوب:

1- استنتج شرط الإشارة الصغيرة (تيار الإشارة عند مأخذ المصرف)

small signal للحصول على تكبير خطي بدون تشويه (Distortion).

2- ما هو الحد الأعظمي المسموح به للتأرجح المتناظر للإشارة عند المصرف

مبيناً ذلك حسابياً وبيانياً على مميزة نقل الجهد VTC.



*[Handwritten signature]*

$$v_{gs} = V_{GS} + v_{gs}$$

-1 [6]

$$i_D = \frac{1}{2} k_n v_{ov}^2 = \frac{1}{2} k_n (v_{gs} - V_t)^2$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_n (v_{gs}^2 - 2v_{gs}V_t + V_t^2)$$

$$i_D = \frac{1}{2} [(V_{GS} + v_{gs})^2 - 2(V_{GS} + v_{gs})V_t + V_t^2]$$

$$i_D = \underbrace{\frac{1}{2} k_n (V_{GS} - V_t)^2}_{I_D} + \underbrace{k_n (V_{GS} - V_t) v_{gs}}_{i_d} + \frac{1}{2} k_n v_{gs}^2$$

المعادلة الثانية أكبر من المعادلة الأولى  
 $\frac{1}{2} k_n v_{gs}^2 \ll k_n (V_{GS} - V_t) v_{gs} \Rightarrow$   
 $v_{gs} \ll 2V_{ov}$

$$V_{ov} = V_{GS} - V_t = 0.6 - 0.1 = 0.5 \text{ V}$$

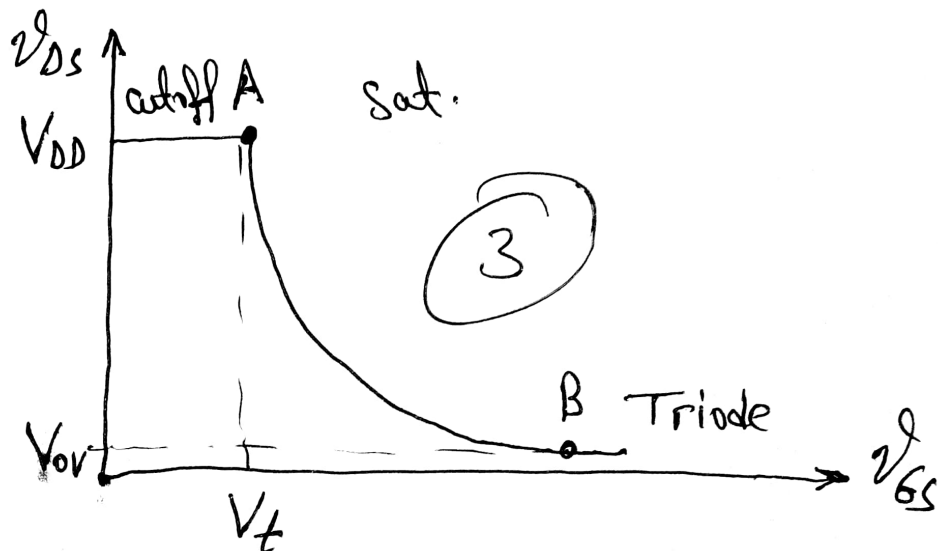
-2 [9]

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = \frac{1}{2} k_n v_{ov}^2 ; k_n = k_n' \frac{W}{L} = 0.4 \times 10$$

$$I_D = \frac{1}{2} \times (0.4) \times (0.5)^2 \times 10 = 0.5 \text{ mA}$$

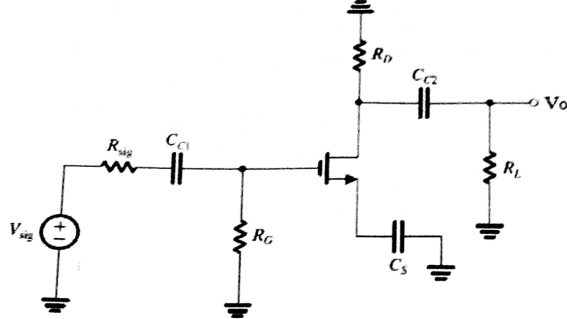
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 1.8 - (0.5)(17.5) = -6.95 \text{ V}$$



الترانزستور في حالة 2 cut-off ولا يوجد إشارة على الخرج

22

السؤال الثالث (22 درجة (12+4+6) لنكن لدينا دائرة المكبر الترانزستوري التالية:



حيث:  $r_o = 150 \text{ k}\Omega$  ،  $g_m = 1 \text{ mA/V}$  ،  $R_{sig} = 100 \text{ k}\Omega$  ،  $R_D = R_L = 15 \text{ k}\Omega$  ،  $R_G = 4.7 \text{ M}\Omega$  ،

$C_{gs} = 1 \text{ pF}$  ،  $C_{gd} = 0.4 \text{ pF}$  ، و  $f_{p1} = f_{p3} = 10 \text{ Hz}$  . والمطلوب:

1- حدد القيم المناسبة للمكثفات  $C_{C1}$  و  $C_{C2}$  و  $C_S$  بحيث نحصل على تردد أدنى يساوي  $f_L = 100 \text{ Hz}$  .

2- ارسم الدارة المكافئة للترددات العالية باستخدام الموديل  $\pi$  الهجين، مع الأخذ بالاعتبار فقط السعتين  $C_{gs}$  و  $C_{gd}$  وتأثير إيرلي.

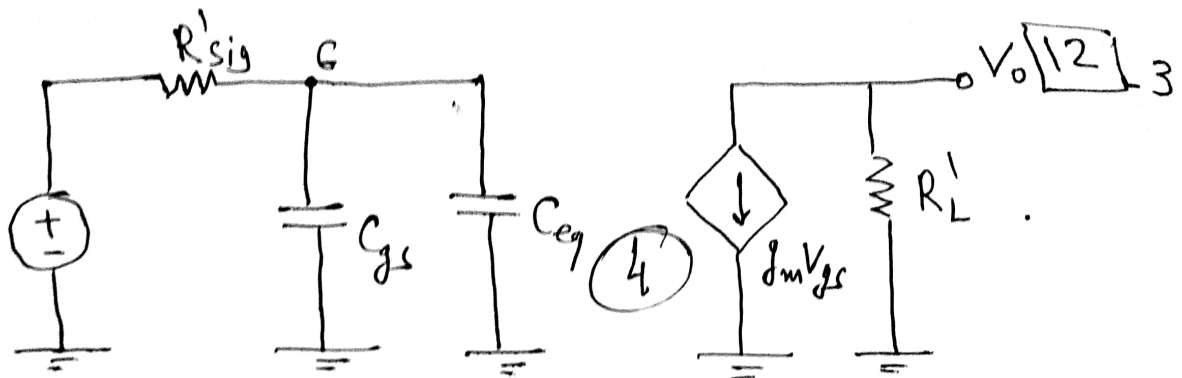
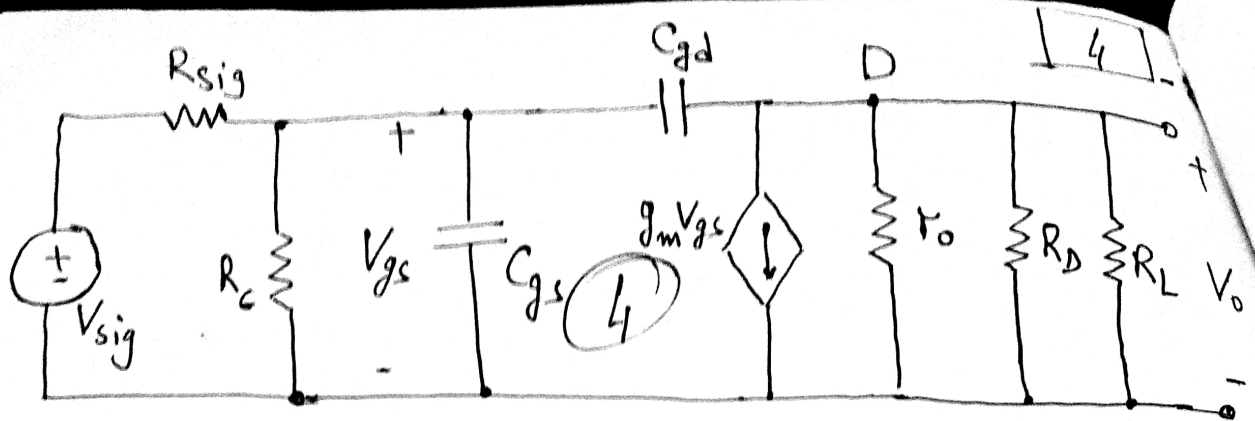
3- ارسم الدارة المبسطة من الدارة المكافئة في الطلب السابق (الطلب 2) مع استبدال السعة  $C_{gd}$  بسعة مكافئة  $C_{eq} = C_{gd}(1 + g_m R'_L)$  موصولة بين البوابة والأرض، حيث  $R'_L = r_o // R_D // R_L$  . ثم أوجد ربح النطاق المتوسط  $A_M$  ، والتردد العلوي  $f_H$  .

$$\omega_{p2} = \frac{g_m}{C_S} \Rightarrow f_L = f_{p2} = \frac{g_m}{2\pi C_S} \Rightarrow \boxed{6} \quad 1$$

$$C_S = \frac{g_m}{2\pi f_L} = \frac{1 \times 10^{-3}}{2\pi \times 100} = 1.6 \mu\text{F} \quad (2)$$

$$C_{C1} = \frac{1}{2\pi f_{p1} (R_G + R_{sig})} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times (0.1 + 4.7) \times 10^6} = 3.3 \mu\text{F} \quad (2)$$

$$C_{C2} = \frac{1}{2\pi f_{p2} (R_D + R_L)} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times (15 + 15) \times 10^3} = 0.53 \mu\text{F} \quad (2)$$



$$A_M = -\frac{R_G}{R_G + R_{sig}} g_m R'_L ;$$

$$R'_L = r_o \parallel R_D \parallel R_L = 150 \parallel 15 \parallel 15 = 7.14 \text{ k}\Omega$$

$$g_m R'_L = 1 \times 7.14 = 7.14 \text{ V/V}$$

$$A_M = -\frac{4.7}{4.7 + 0.1} \times 7.14 = -7 \text{ V/V}$$

$$C_{eq} = (1 + g_m R'_L) C_{gd} = (1 + 7.14) \times 0.4 = 3.26 \text{ pF}$$

$$C_{in} = C_{gs} + C_{eq} = 1 + 3.26 = 4.26 \text{ pF}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi C_{in} (R_{sig} \parallel R_G)}$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \times 4.26 \times 10^{-12} (0.1 \parallel 4.7) \times 10^6} = 382 \text{ kHz}$$

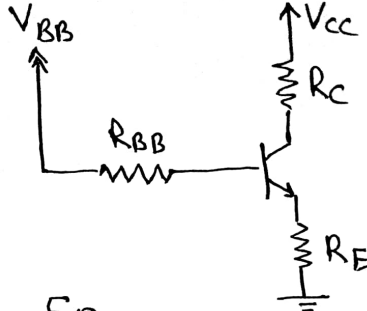
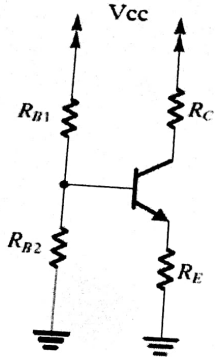
13

السؤال الرابع © 13 درجة (3+10)

لتكن لدينا الدارة التالية: حيث:  $V_{CC}=15\text{ V}$ ,  $R_{B1}=100\text{ k}\Omega$ ,  $R_{B2}=50\text{ k}\Omega$ ,  $R_C=5\text{ k}\Omega$ ,  $R_E=3\text{ k}\Omega$ ,  $V_{BE}=0.7\text{ V}$ ,  $\beta=100$ . والمطلوب:

1- بافتراض العمل في النمط الفعال حدد قيم الجهود في جميع العقد والتيارات في جميع الفروع.

2- تحقق من أن الترانزستور حقاً يعمل في النمط الفعال.



$$\textcircled{1} V_{BB} = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 15 \frac{50}{50 + 100} = 5\text{ V}$$

$$\textcircled{1} R_{BB} = \frac{R_{B1} \cdot R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = \frac{100 \times 50}{100 + 50} = 33.33\text{ k}\Omega$$

$$\textcircled{1} V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

وبافتراض العمل في النمط الفعال:

$$\textcircled{1} V_{BB} = \frac{I_E}{\beta + 1} R_{BB} + I_E R_E + V_{BE}$$

$$\textcircled{1} I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + R_{BB}/\beta + 1} = 1.29\text{ mA}$$

$$\textcircled{1} I_B = \frac{I_E}{\beta + 1} = \frac{1.29}{100 + 1} = 0.0128\text{ mA}$$

$$\textcircled{1} V_B = V_{BE} + I_E R_E = 0.7 + 1.29 \times 3 = 4.57\text{ V}$$

$$\textcircled{1} I_C \approx I_E = 0.99 \times 1.29 = 1.28\text{ mA}$$

$$\textcircled{1} V_C = V_{CC} - I_C R_C = 15 - 1.28 \times 5 = 8.6\text{ V}$$

$$V_{BE} = V_B - V_E \Rightarrow V_E = V_B - V_{BE} = 4.57 - 0.7 = 3.87\text{ V}$$

2- بما أن  $V_C > V_B > V_E$  فإن الترانزستور يعمل في النمط الفعال

د.م عبد المعين الرفاعي

تمنياتي بالتوفيق والنجاح

انتهت الأسئلة